УДК 620.3

Modification of Spray-Method for Producing of Single-Walled Carbon Nanotubes Films and Their Properties

Anton S. Voronin^{a,b,c*}, Fedor S. Ivanchenko^{a,b}, Michael M. Simunin^{b,d}, Aleksei I. Lyamkin^{a,c}, Yuri V. Fadeev^b, Aleksey V. Shiverskiy^{a,b} and Stanislav V. Khartov^{b,c} ^aSiberian Federal University 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia ^bLtd. «FunNano» 50 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia ^cMolecular Electronic Department, KSC SB RAS 50 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia ^dNational Research University «MIET» 5 travel 4806, Zelenograd, Moscow, 124498, Russia

Received 16.01.2015, received in revised form 20.02.2015, accepted 02.03.2015

The technique of forming thin films of single-walled carbon nanotubes by ultrasonic spraying an aqueous dispersion. The developed technique allows to form a film of single-walled carbon nanotubes of large area and highly homogeneous. The technique allows to form a nanotube coating on the surfaces of complex shape. Using this method, the transparent electrodes are formed characterized by transparency of 77 % and a surface resistivity of 210 ohms / square, and transparency in the infrared range of more than 91 %.

Keywords: single-walled carbon nanotube transparent electrodes, ultrasonic spraying, optoelectronics.

[©] Siberian Federal University. All rights reserved

^{*} Corresponding author E-mail address: a.voronin1988@mail.ru

Модифицирование spray- метода для получения пленок однослойных углеродных нанотрубок и их свойства

А.С. Воронин^{а,б,в}, Ф.С. Иванченко^{а,б}, М.М. Симунин^{б,г}, А.И. Лямкин^{а,в}, Ю.В. Фадеев⁶, А.В. Шиверский^{а,б}, С.В. Хартов^{6,в} ^а Сибирский федеральный университет Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 ^бООО «ФанНано» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50 ^е Отдел молекулярной электроники КНЦ СО РАН Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50 ^г Национальный исследовательский университет «МИЭТ» Россия, 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, 5

Разработана методика формирования тонких пленок однослойных углеродных нанотрубок посредством ультразвукового распыления водной дисперсии. Методика позволяет формировать пленки однослойных углеродных нанотрубок большой площади и высокой однородности, на поверхностях сложной формы. При помощи данной методики сформированы прозрачные электроды, характеризующиеся прозрачностью 77 % и удельным поверхностным сопротивлением 210 Ом/кв, а также прозрачностью в инфракрасном диапазоне более 91 %.

Ключевые слова: однослойные углеродные нанотрубки, прозрачные электроды, ультразвуковое распыление, оптоэлектроника.

Введение

Прозрачные электроды имеют существенное практическое значение [1]. Они находят своё применение для изготовления таких объектов техники, как электрохромные стёкла [2]; электроды для органических светодиодов [3], электронной бумаги, солнечных батарей [4], различных оптоэлектронных приборов; а также защита от электростатики, система экранирования электромагнитных полей и др.

На текущий момент наиболее распространённым техническим решением является применение покрытий, выполненных на основе проводящих оксидов металлов [5]. В частности, широко используется покрытие на основе индий-оловянного оксида (ITO). К основным недостаткам покрытий данного типа следует отнести довольно высокую стоимость и прогноз её повышения, существенные ограничения по допустимым подложкам (обусловлено методом формирования), значительную потерю прозрачности в ИК-области спектра, низкую механическую гибкость и эластичность. Преимущество – высокое соотношение оптической прозрачности и поверхностного сопротивления: 10 Ом/кв при 80 % прозрачности.

Однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ) интенсивно исследуются для их дальнейшего применения в электронике [6]. Одной из возможных областей, где ОУНТ могут раскрыть свой потенциал, признано изготовление оптически прозрачных проводящих пленок [7-9]. В отличие от оксидных прозрачных электродов нанотрубные обладают высокой гибкостью и прозрачностью в ИК-диапазоне. Наиболее перспективными методиками формирования пленок ОУНТ большой площади являются spray-метод [10-12] и метод микроструйной печати (ink jet) [13].

Методика формирования тонких пленок ОУНТ

Главным недостатком классического spray-метода выступает большой размер капель – 30-50 мкм, в результате чего происходит их слияние, что создает оптические неоднородности на пленке.

Предлагаемая методика формирования пленок ОУНТ позволяет решить проблему макроскопических неоднородностей за счет применения ультразвукового диспергирования коллоидной системы вода+ОУНТ (использовали ультразвуковой ингалятор модели «РОТОР» Муссон-1М, рабочая частота 2,64 МГц). При этом происходит формирование и отрыв микрокапель с поверхности коллоидного раствора. Размер капель имеет различное наполнение, которое очень зависит от степени агрегации коллоида, и находится в диапазоне 3-5 мкм. Получившийся аэрозоль ОУНТ подается в рабочую камеру, где разбивается потоком воздуха о подложку. На рис. 1*а* показана схема процесса синтеза тонких пленок ОУНТ.

Главными параметрами контроля получаемых пленок служат концентрация коллоида и время напуска аэрозоля. На рис. 16 представлены расчетные зависимости толщин пленок ОУНТ от количества импульсов осаждения для стабильного коллоидного раствора с концентрацией нанотрубок 4·10⁻³ г/л при различных временах напуска (1, 2 и 3 с). Увеличение времени напуска аэрозоля ведет к коалесценции капель, в результате которой на подложке появляются неоднородности.

При наличии в коллоидном растворе агрегатов нанотрубок, а также элементов с линейным размером более 5 мкм за счет кавитации происходит разрушение стуктуры материала в агрегатах и микрокапли наполняются фрагментами нанотрубок.



Рис. 1: a – схема формирования пленок ОУНТ модифицированным spray-методом; δ – зависимость толщины пленок ОУНТ от количества импульсов осаждения для трех времен напуска аэрозоля

Синтез образцов и методика эксперимента

В качестве материала для синтеза пленок ОУНТ были использованы ОУНТ, полученные методом электродогового испарения на катализаторе Ni/Y. Нанотрубный материал получен А.В. Крестининым (ИПХФ РАН, ООО «Углерод ЧГ»), содержание ОУНТ 90 %, средний диаметр нанотрубок 1,5 нм. Степень агрегации низкая, материал представляет собой тяжи нанотрубок длиной 2-10 мкм и радиусом до 10 нм.

Концентрация ОУНТ в водной дисперсии составляла 4·10⁻³ г/л. Для стабилизации дисперсии в раствор вводили цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ) с содержанием 4·10⁻⁴ г/л. Дальнейшее повышение концентрации ЦТАБ замедляет процесс высыхания капель, и на пленке появляются разводы.

Для исследований на подложках из щелочного стекла площадью 4 см² формировались пленки ОУНТ четырех видов толщины (50, 100, 150 и 200 итераций). Время единичного напуска аэрозоля составляло 2 с. После каждой итерации система сушилась в течение 30 с. Для удаления ЦТАБ готовые пленки ОУНТ отжигали на воздухе при 400 °C в течение 60 с. Макрои микроструктура пленки ОУНТ толщиной 100 итераций показана на рис. 2.

Изображения демонстрируют высокую однородность пленки ОУНТ как на макро-, так и на микромасштабе, что является доказательством перспективности разработанного метода.

После процедуры отжига пленки ОУНТ подвергались дырочному допированию обработкой пленок в парах азотной кислоты. Обработка проводилась по методике, описанной в [14], время экспонирования составляло 2,5 ч. При воздействии на ОУНТ парами азотной кислоты происходит функционализация боковой поверхности карбоксильными, карбонильными и гидроксильными группами [15].

Макроструктура пленок изучалась при помощи оптического микроскопа. Для исследования микроструктуры пленок ОУНТ использовался сканирующий электронный микроскоп Hitachi S 5500.



Рис. 2: *а* – макроструктура пленок ОУНТ (100 итераций осаждения); *б* – микроструктура пленок ОУНТ (100 итераций осаждения); *в* – демонстрация высокой однородности и прозрачности пленки ОУНТ (100 итераций осаждения)

Для измерения поверхностного сопротивления на пленках ОУНТ магнетронным напылением формировалась пара медных контактов толщиной 150 нм.

Измерения оптического пропускания пленок в диапазоне 400-2000 нм производились при помощи спектрофотометра Shimadzu UV 3600.

Результаты и обсуждение

Пронализируем спектры оптического пропускания пленок ОУНТ (рис. 3*a*) на подложках из щелочного стекла различной толщины (50, 100, 150, 200 итераций осаждения). Пики поглощения соответствуют электронным переходам между особенностями ван Хова в плотности состояний одномерных систем [16, 17], для полупроводниковых (λ (S₁₁)=1873 нм и λ (S₂₂)=1036 нм) и металлических (λ (M₁₁)=712 нм) нанотрубок. Из спектров видно, что пики переходов для металлических трубок проявляются слабее пиков, соответствующих полупроводниковым переходам, из чего можно сделать вывод о меньшем процентном содержании металлических УНТ в исходной пасте нанотрубок. В действительности литературные данные показывают, что при дуговом методе синтеза ОУНТ на выходе получается 1/3 металлических и 2/3 полупроводниковых нанотрубок различной хиральности [18]. После операции экспонирования пленок парами азотной кислоты спектральные зависимости оптического пропускания претерпевают значительное изменение (рис. 3*b*). В частности, полностью пропадает пик S₁₁ и значительно снижается интенсивность пика S₂₂. Причиной данного изменения спектров служит сдвиг уров-



Рис. 3: *а* – спектральные зависимости оптического пропускания исходных пленок ОУНТ; *б* – спектральные зависимости оптического пропускания пленок ОУНТ, экспонированных парами азотной кислоты; *в* – схематический вид функции плотности состояний для полупроводниковых и металлических ОУНТ[14]



Рис. 4: *а* – зависимость удельного поверхностного сопротивления пленок ОУНТ от количества итераций осаждения; *б* – зависимость оптического пропускания пленок ОУНТ от величины удельного поверхностного сопротивления; *в* – временная зависимость уменьшения поверхностного сопротивления для пленки толщиной 100 итераций; *г* – абсолютное уменьшение поверхностного сопротивления для пленок ОУНТ всех толщин

ня Ферми в валентную зону. Очевидно, что при этом уровень Ферми оказывается ниже первой сингулярности ван Хова для полупроводниковых нанотрубок. Как следствие, происходит опустошение энергетических уровней и электронные переходы между сингулярностями ван Хова становятся невозможными.

Неполное гашение пиков S₂₂ и M₁₁, по-видимому, связано с недостаточным временем обработки парами азотной кислоты.

На рис. 4*a* представлены зависимости удельного поверхностного сопротивления пленок ОУНТ от количества итераций осаждения для случая недопированных и допированных пленок ОУНТ.

В целом операция допирования азотной кислотой позволяет увеличить проводимость пленок в 6-9 раз (рис. 4*г*). В частности, на образце толщиной 200 итераций получено значение удельного поверхностного сопротивления 210 Ом/кв при оптическом пропускании 77 %. Заслуживает внимания тот факт, что при операции химического допирования за счет подавления пиков поглощения в инфракрасной области происходит значительное просветление пленок. Так, удалось просветлить образец толщиной 200 итераций с 67 до 91 % на длине волны 1873 нм, в то время как прозрачность наиболее востребованного коммерческого прозрачного покрытия (ITO) после длины волны 1200 нм начинает монотонно падать.

Заключение

В работе предложена методика получения пленок однослойных углеродных нанотрубок посредством ультразвукового распыления нанотрубного коллоидного раствора. Методика яв-

ляется модификацией традиционного spray-метода. Уменьшение на порядок размера капель распыляемого аэрозоля улучшает однородность пленки ОУНТ и способствует получению более качественного покрытия по сравнению с покрытиями, получаемыми традиционным spray-методом. При допировании пленок ОУНТ парами азотной кислоты их поверхностное сопротивление уменьшается в 6-9 раз. При этом за счет подавления электронных переходов между сингулярностями ван Хова происходит значительное просветление пленок ОУНТ, что уже сейчас позволяет рассматривать пленки ОУНТ как альтернативу ITO в приложениях, использующих инфракрасный диапазон.

Список литературы

- [1] Hecht D.S., Hu, L.B., Irvin, G.// Adv.Mater. 2011. № 23. P. 1482.
- [2] *Tung T.S., Ho K.C.* // Sol. Energ. Mat. Sol. 2006. № 90. P. 521.
- [3] Liu H.Y., Avrutin V., Izyumskaya N. etc. //Superlattices Microstruct. 2010. № 48(5). P. 458.
- [4] Wang X., Zhi L.J., Mullen K. // Nano Lett. 2008. № 8. P. 323.
- [5] Minami T. // Semicond. Sci. Technol. 2005. № 20. P. 35.
- [6] *Iijima S.* // Nature. 1991. № 354. P. 56.
- [7] Hu L., Hecht D.S., Gruner, G.// Nano Lett. 2004. № 4. P. 2513.
- [8] Feng C., Liu K., Wu J.S. etc. // Adv. Funct. Mater. 2010. № 20. P. 885.
- [9] Pasquier A.D., Unalan H.E., Kanwal A. etc. // Appl. Phys. Lett. 2005. № 87. P. 203511.
- [10] Jeong M., Lee K., Choi E. etc. // Nanotechnology. 2012. № 23. P. 505203
- [11] Pu J., Wan S., Lu Z. etc. // J. Mater. Chem. A. 2013. № 1. P.1254.
- [12] Scardaci V., Coull R., Coleman J.N.// Appl. Phys. Lett. 2010. № 97. P. 023114.
- [13] Fischer T., Wetzold N., Elsner H. etc. // Nanomater. nanotechnol. 2011. № 1. P. 18.
- [14] Shin D.W., Lee J.H., Kim Y.H. etc. // Nanotechnology. 2009. № 20. P. 475703.
- [15] Jackson R., Domercq B., Jain R. etc. // Adv. Funct. Mater. 2008. № 18. P. 2548.
- [16] Харламова М.В., Ниу Дж. // ЖЭТФ. 2012. Т. 142. Вып. 3(9). С. 547.
- [17] Pekker A., Borondics F., Kamaras K. etc. // Phys. stat. sol. (b). 2006. № 13. P. 3485.
- [18] Krupke R., Hennrich F., Lohneysen H., Kappes M.M. // Science. 2003. № 301. P. 344.